

Si-PIN-Fotodiode Typ FD-30

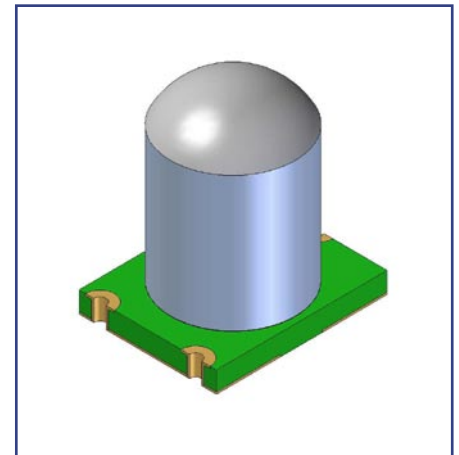


**MERKMALE**

- ▶ Erhöhte Empfindlichkeit
- ▶ Integrierte, abgestimmte Hochleistungsoptik
- ▶ Keine zusätzlichen Linsen erforderlich
- ▶ Extrem kleine Empfangs- und Schielwinkel
- ▶ 3mm-Bauform, Metallgehäuse

**ANWENDUNG**

- ▶ Für optische Sensoren



▶ **GRENZWERTE**

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Betriebstemperatur ( $T_{Op}$ )		-20 / + 70	°C
Sperrspannung ( $V_R$ )		> 50	V

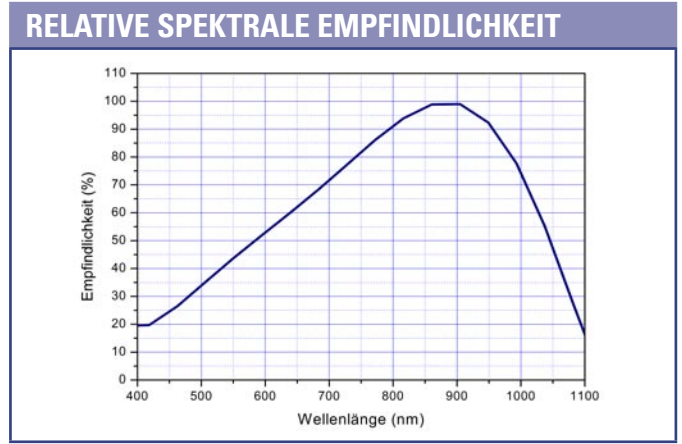
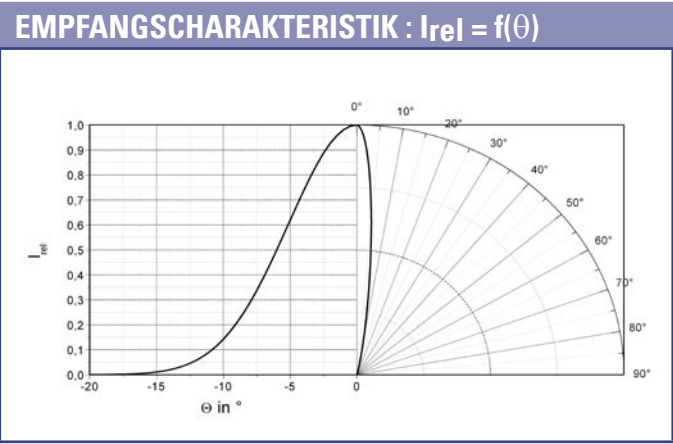
▶ **OPTISCHE UND ELEKTRONISCHE KENNWERTE (bei  $T=25^\circ\text{C}$ )**

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Chipgröße		0,76 x 0,76	mm x mm
Chipdicke		0,24	mm
Bestrahlungsempfindliche Fläche		0,55 x 0,55	mm x mm
Spektrale Fotoempfindlichkeit	650nm 875nm 940nm	0,26 0,44 0,35	A / W
Empfangswinkel ( $\theta$ )		8	Grad
Dunkelstrom	$V_R = 15\text{V}$	< 4 (Typ. 0,2)	nA
Anstiegs – und Abfallzeit des Fotostromes	$V_R = 20\text{V}$ , $\lambda = 860\text{nm}$ , $R = 50\ \Omega$	10	ns
Grenzfrequenz (-3dB)	$V_R = 20\text{V}$ , $\lambda = 860\text{nm}$ , $R = 50\ \Omega$	35	MHz
Rauschäquivalente Strahlungsleistung (Noise equivalent power)	$V_R = 0\text{V}$ $\lambda = 900\text{nm}$	$6 \times 10^{-15}$	$\frac{W}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Kapazität	$V_R = 15\text{V}$	0,6	pF

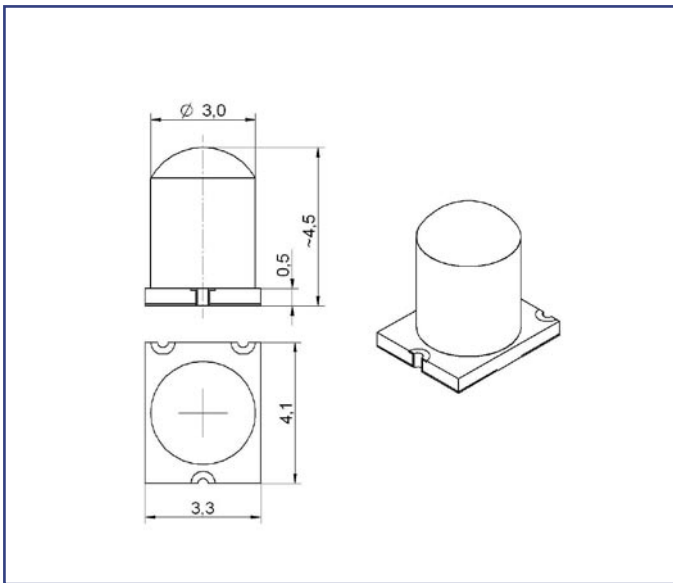


# Si-PIN-Fotodiode Typ FD-30

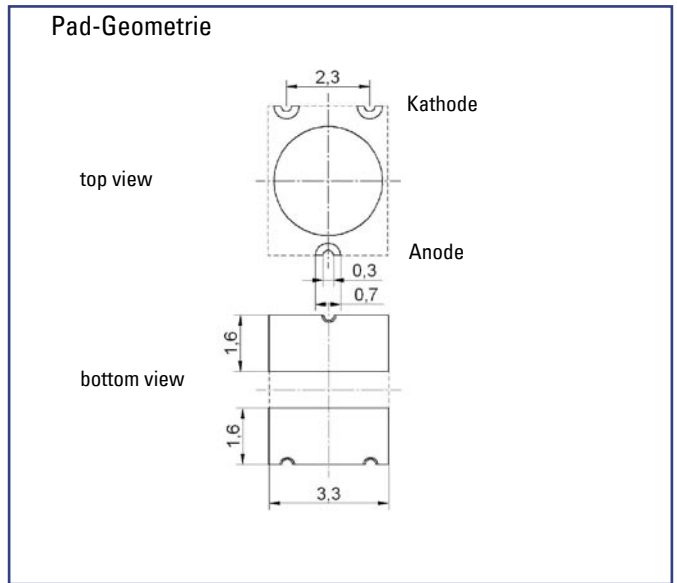
► **DIAGRAMME**



► **ABMESSUNGEN GEHÄUSE**



► **ANSCHLÜSSE**



**BESTELLBEZEICHNUNG**

**OE-FD-30-VA1-SL21-9-0114**